Catálogo de productos

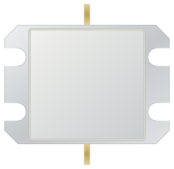
Transistores de potencia RF

Los transistores de potencia RF convierten la polarización y la excitación RF en potencia de salida dentro de una etapa amplificadora. Se emplean en cadenas de transmisión, módulos de potencia RF, equipos industriales y bancos de prueba de alta potencia.



Productos: 11

Revisión: 10 · Fecha de revisión: 2026-11-11



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 51 dBm (típico)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (típico); Ganancia de potencia 11 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5700; Máximo: 7100; Valor: 5700–7100; Unidad: MHz

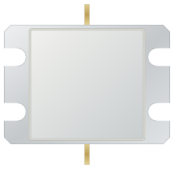
Potencia de salida saturada: Mínimo: 50.5; Típico: 51; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 10.5; Típico: 11; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 40; Típico: 45; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 56.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 13.5 dB (típico); PAE 55 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Mínimo: 56; Típico: 56.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 13; Típico: 13.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 50; Típico: 55; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 56.5 dBm (típico)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 12.5 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5300; Máximo: 5900; Valor: 5300–5900; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Mínimo: 56; Típico: 56.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 12; Típico: 12.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 40; Típico: 45; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 48.5 dBm (típico)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 12.5 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidad: MHz

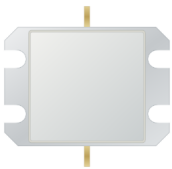
Potencia de salida saturada: Mínimo: 48; Típico: 48.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 12; Típico: 12.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 53.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 13.5 dB (típico); PAE 65 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

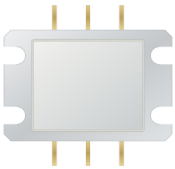
Potencia de salida saturada: Mínimo: 53; Típico: 53.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 13; Típico: 13.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 60; Típico: 65; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 50 dBm (típico)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (típico); Ganancia de potencia 12 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2300; Máximo: 3900; Valor: 2300–3900; Unidad: MHz

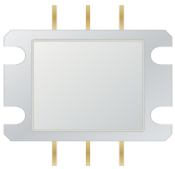
Potencia de salida saturada: Mínimo: 49; Típico: 50; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 11; Típico: 12; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidad: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 49 dBm (típico)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (típico); Ganancia de potencia 13 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2600; Máximo: 3700; Valor: 2600–3700; Unidad: MHz

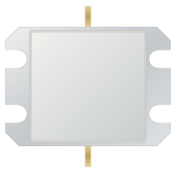
Potencia de salida saturada: Mínimo: 48; Típico: 49; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 12; Típico: 13; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 51 dBm (típico)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (típico); Ganancia de potencia 9 dB (típico); PAE 38 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 9600; Valor: 8500–9600; Unidad: MHz

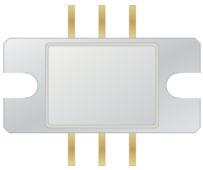
Potencia de salida saturada: Mínimo: 50; Típico: 51; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 8; Típico: 9; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Típico: 38; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (típico)

2000–6000 MHz; Potencia de salida de referencia 45.51 dBm (típico); Ganancia de potencia 19.51 dB (típico); Eficiencia de drenador 39.82 % (típico) @ 6000 MHz.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

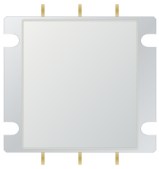
Potencia de salida de referencia: Típico: 45.51; Unidad: dBm; Notas: f = 6000 MHz

Ganancia de potencia: Típico: 19.51; Unidad: dB; Notas: f = 6000 MHz

Eficiencia de drenador: Símbolo: ηD; Típico: 39.82; Unidad: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (típico)

700–6200 MHz; Potencia de salida saturada 49 dBm (típico); Ganancia de potencia 7 dB (típico); Eficiencia de drenador 35 % (típico) @ 6000 MHz.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 700; Máximo: 6200; Valor: 700–6200; Unidad: MHz

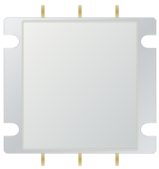
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 49; Unidad: dBm; Notas: f = 6000 MHz

Ganancia de potencia: Típico: 7; Unidad: dB; Notas: f = 6000 MHz

Eficiencia de drenador: Símbolo: ηD; Típico: 35; Unidad: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (típico)

2000–6200 MHz; Potencia de salida de referencia 50.1 dBm (típico); Ganancia de potencia 8.6 dB (típico); Eficiencia de drenador 52.4 % (típico) @ 6000 MHz.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6200; Valor: 2000–6200; Unidad: MHz

Potencia de salida de referencia: Típico: 50.1; Unidad: dBm; Notas: f = 6000 MHz

Ganancia de potencia: Típico: 8.6; Unidad: dB; Notas: f = 6000 MHz

Eficiencia de drenador: Símbolo: ηD; Típico: 52.4; Unidad: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.